

الگوی نشست نانوذرات اکسیدقلع تحت اعمال میدان‌های الکتریکی متناوب غیر یکنواخت

بتول مهرعلیان^{*}، بابک رئیسی^۱، رضا ریاحی‌فر^۱، مازیار صهبا یغمایی^۱

^۱ پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک، کرج، ایران.

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۳/۵/۱۳، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۴/۸/۱۸، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹

چکیده در این پژوهش، الگوی نشست نانوذرات اکسید قلع در محیط استن با اعمال میدان الکتریکی متناوب غیر یکنواخت بر روی الکترودهای مسطح طلا مطالعه شده است. یکی از پارامترهای اساسی تاثیرگذار بر رفتار الکتروکیتیکی ذرات تحت اعمال میدان‌های الکتریکی، اندازه ذرات است. مشاهدات لایه نشانی در فرکانس 10 kHz نشان دهنده وجود ذرات میکرومتری بر سطح الکترودهای نشست است. در این مطالعه، عامل اندازه ذرات از دیدگاه ترسیم مقادیر فاکتور کلاسیوس- ماسوتی نشان دهنده وجود نیروی دی الکتروفورز منفی برای ذرات درشت و نیروی دی الکتروفورز مثبت برای ذرات ریز است.

کلمات کلیدی: الکتروکیتیک، کلاسیوس- ماسوتی، دی الکتروفورزیس، نانوذرات اکسیدقلع.

Deposition pattern Of Tin Oxide Nanoparticles Under Non-uniform AC Electric Fields

Batuol Mehralian^{*1}, Babak Raissi¹, Reza Riahifar¹, Maziar Safhba Yaghmayee¹

¹Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran.

Abstract In this research, deposition pattern of tin oxide nanoparticles in acetone media under non-uniform AC electric fields on planar gold electrodes have been studied. Particle size is one of the basic parameters affecting the electrokinetic behavior of particles under applied electric fields. Based on deposition pattern observations, micron size particles were deposited on electrode surface at frequency of 10 kHz . In this study, Clausius- Mossotti factor was depicted for different particle sizes. It indicates that for coarse particles dielectrophoretic force is negative and for fine particles dielectrophoretic force is positive.

Keywords: Electrokinetic, Clausius Mossotti factor, Dielectrophoresis, Tin oxide nanoparticles.

^{*}عهده دار مکاتبات

نشانی: کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی، تلفن: ۰۹۱۲۸۹۹۴۶۴۰، پیام نگار: bmehralian@yahoo.com

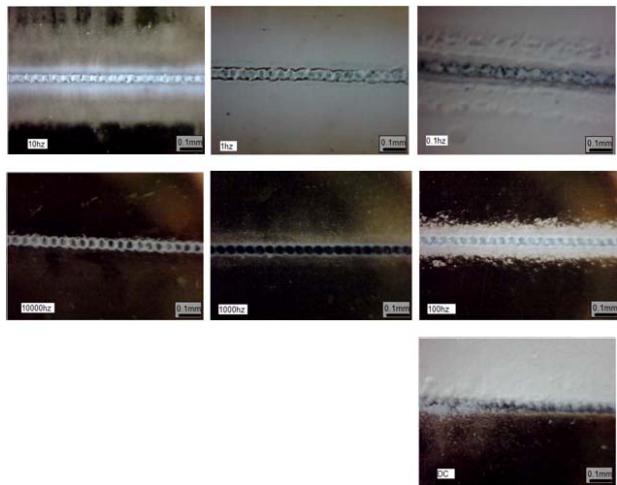
غلهٔ ۰/۲ gr/L و آمده سازی سوسپانسیون در حمام آلتروسونیک مدل RETSCH url به مدت ۱۵ دقیقه، لایه نشانی در ولتاژ و زمان به ترتیب ۴۰V و ۳ دقیقه در فرکانس-های ۰ تا ۱۰ کیلوهرتز به صورت تصاعدی با ضربی ۱۰ انجام شد. سطح پوشش‌های ایجاد شده توسط میکروسکوپ استریو صنایع اپتیک اصفهان مدل ZSM-۳E-۱۰۰۱-۴۵۰۰ Nikon Coolpix مشاهده و توسط دوربین دیجیتالی HAS, Molvern, u.k.) عکسبرداری شد. همچنین توزیع اندازه ذرات اکسیدقلع در محلول از طریق آنالیز اندازه ذره به وسیله دستگاه زتمتر (۳۰۰۰ HAS, Molvern, u.k.) برآورد شد.



شکل ۱. تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی نانوذرات اکسیدقلع Fluka

۳- نتایج و بحث

تصویر میکروسکوپی از سطح لایه‌نشانی در فرکانس‌های مختلف بر روی الکترود در شکل (۲) نشان داده است.



شکل ۲. لایه‌نشانی در میدان الکترونیکی متناسب غیریکنواخت ۴۰V و زمان ۳ دقیقه تحت فرکانس‌های متفاوت.

۱- مقدمه

نشست ذرات تحت اثر پدیده‌های متنوع الکتروکیتیکی موضوع مباحثات متعددی در سال‌های اخیر بوده است [۱-۳]. لایه نشانی الکتروفورتیکی ذرات تحت اعمال میدان‌های الکترونیکی مستقیم بیش از صد سال مورد توجه محققین این موضوع بوده و کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف تجاری، نظامی، پزشکی، داروسازی داشته است. در سال‌های اخیر استفاده از میدان‌های الکترونیکی متناسب در لایه نشانی الکتروفورتیکی به علت مزایایی همچون افزایش نرخ لایه نشانی، کاهش مصرف انرژی، کاهش واکنش‌های الکترولیز در محلول‌های آبی و استحکام و یکنواختی بهتر پوشش‌های ایجاد شده مورد توجه محققین این حوزه قرار گرفته است. در خصوص ذرات سرامیکی به خصوص اکسیدی به لحاظ تاثیرگذاری و نقش بار الکترونیکی این نتایج از تنوع بیشتری برخوردار می‌باشد. در عین حال حصول الگوهای متنوع در لایه نشانی به خصوص با ظهور و استفاده از ترکیبات نانو و غیر ایزوتروپیک و استعداد بهره‌گیری از لایه‌نشانی جهت‌دار و همجهت در ذرات می‌توان کاربردهای مختلفی را متصور شد [۴-۵]. مهندسی حرکت و نشست ذرات نانو و ساخت قطعات نانوالکترونیک در این راستا قابل بررسی می‌باشد.

تحقیقات نشان داده عوامل بسیاری همچون حلال، ولتاژ، زمان و غلهٔ سوسپانسیون [۱] بر رفتار لایه نشانی ذرات در میدان‌های الکترونیکی متناسب تاثیرگذار است. در این تحقیق رفتار الکتروکیتیکی و عواملی مختلف همچون فرکانس و اندازه ذره و تاثیر آنها بر رفتار نشست نانوذرات بررسی می‌گردد. ماده اولیه مورد بررسی اکسیدقلع با دانه‌بندی نانو است که یکی از ترکیبات نیمه‌هادی پرکاربرد در صنایع نیمه‌هادی می‌باشد.

۲- روش تحقیق

ماده مورد آزمایش ((SnO₂-Fluka (#CH-۹۴۷۰)) با تصویر میکروسکوپی نشان داده شده در شکل (۱)، در محیط استن (۱۰۰۱۳ Merck #۱۰۰۱۳) پراکنده سازی شده است. از الکترودهای طلا هم صفحه برای انجام لایه‌نشانی میدان الکترونیکی متناسب استفاده شد. با انتخاب محلول با

همان طور که در شکل (۲) مشاهده می‌شود ذرات اکسیدقلع موجود در محلول حین لایه‌نشانی در فرکانس 10Hz به صورت متناوب حرکت می‌کنند. در این فرکانس ذرات زمان بیشتری برای حرکت دارند و با رساندن خود به سطح الکترود، علاوه بر پوشش‌دهی داخل شیار سطوح الکترودها را نیز پوشش می‌دهند. به عبارت دیگر در این فرکانس ذره زمان بیشتری برای حرکت در هر نیم‌سیکل و توانایی پیمایش مسافت بیشتری را دارد. این امر باعث می‌شود ذراتی که در لبه الکترود قرار دارند در هر نیم سیکل خود را به سطح الکترود رسانده و در آنجا نشست یابند. در این فرکانس ذرات به علت داشتن زمان بیشتر در هر نیم سیکل قادر به پوشش‌دهی نسبتاً بیشتری هستند و با تغییر پلاریته میدان، لایه نشانی بر دو سطح الکترود انجام می‌گیرد.

در فرکانس‌های $10-1\text{Hz}$ از آنجایی که زمان در دسترس برای حرکت ذرات در هر نیم‌سیکل کاهش پیدا کرده، انتظار می‌رود ذرات با طی نمودن مسیر کوتاه‌تر، توانند از لبه الکترود فاصله زیادی بگیرند. بنابراین مساحت نشست ذرات در سطح الکترود نسبت به نشست در فرکانس 10Hz کاهش یافته است. در این محدوده فرکانسی، لایه‌نشانی الکتروفورتیکی باعث پوشش‌دهی در قسمتی از سطح الکترود و همچنین داخل شیار شده است.

لایه‌نشانی ذرات اکسید قلع در فرکانس 100Hz برخلاف باورهای گذشته [۹۰] می‌تواند در درون گپ نیز اتفاق بیفتد و تنها نیروی غالب در مباحث عدم نشست در دیگر ذرات سرامیکی، الکترواسمنز نیست. به دلیل ضعف نسبی نیروی الکترواسمنز، نیروهای الکتروفورز، دی‌الکتروفورز و انحراف خطوط میدان در اثر پتانسیل زیرلایه شیشه‌ای [۱۰] سبب نشست ذرات در گپ و قسمت‌هایی از لبه الکترودها شده است.

در فرکانس 1kHz با افزایش سرعت سیال، شستشوی ذرات بیشتر از سمت لبه و گپ است و نشست درون گپ انجام نمی‌شود. با افزایش فرکانس و کاهش زمان حرکت ذره در هر نیم‌سیکل، برد حرکتی ذره کمتر و سطح ناچیزی از الکترودها توسط نانوذرات اکسید قلع پوشش داده می‌شود. این روند کاهش مقدار نشست پوشش با افزایش فرکانس ادامه می‌پابد و در نهایت در فرکانس‌های بیشتر از 1kHz با افزایش

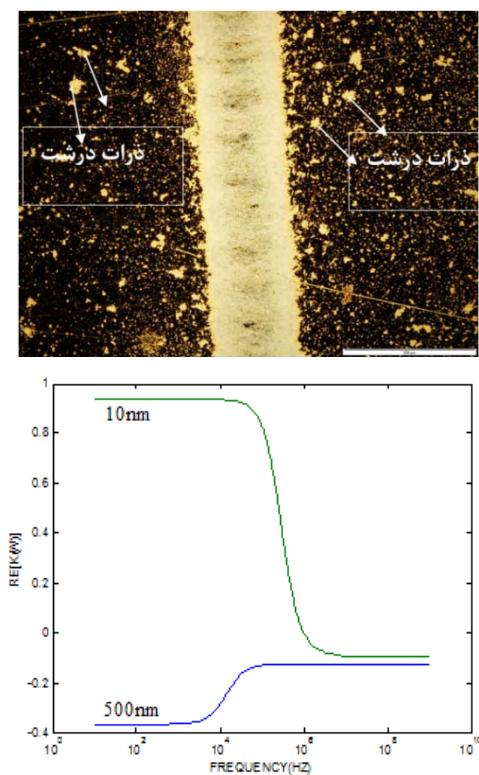
براساس شکل (۲) در اثر اعمال میدان الکتریکی با تناوب صفر ذرات اکسیدقلع به علت داشتن بار سطحی منفی تحت تاثیر نیروی الکتروفورز در جهت خطوط میدان به سمت الکترود با بار مخالف حرکت می‌کنند که در نهایت منجر به نشست آنها بر سطح الکترود مثبت می‌شود. مقدار پتانسیل زتای $-26/81$ میلی ولتی برای سوسپانسیون ذرات اکسید قلع نشان دهنده نوع بار لایه مضاعف الکتریکی حول ذرات است. بنابراین، مشاهده علامت منفی برای پتانسیل زتا نشان دهنده منفی بودن بار سطحی ذرات اکسید قلع می‌باشد که نشست ذرات بر روی قطب مثبت را توجیه می‌کند.

تحت اثر میدان متناوب غیریکنواخت، جابه‌جایی خالص ذره صفر نیست و برآیند حرکت در دو نیم‌سیکل صفر نمی‌باشد بنابراین امکان نزدیک شدن ذرات به الکترودها و نشست بر سطح هر الکترود امکان‌پذیر می‌باشد. اما سوال مهم در این قسمت دلیل نشست ذرات در میدان متناوب متقارن است زیرا در هر نیم‌سیکل ذرات به یک اندازه به سوی الکترودها نزدیک می‌شوند و با تغییر پلاریته میدان الکتریکی رفتار برگشت‌پذیر ذرات سبب برگشت آنها به مختصات قبلی می‌شود. بنابراین، عملاً باید هیچ برآیند حرکتی در میدان الکتریکی متناوب وجود نداشته باشد. اما پژوهش‌ها [۲] حاکی از وجود نیروهای دیگری همچون الکترواسمنز، جریان سیال پایدار و دی‌الکتروفورز است که در فرکانس‌های متفاوت اندازه‌های مختلفی دارند و سبب تغییر در الگوی نشست ذرات می‌شوند.

لایه‌نشانی در میدان الکتریکی متناوب، نرخ نشست ذرات را افزایش می‌دهد زیرا در میدان الکتریکی مستقیم بسته به کاتدیک و یا آندیک بودن الکتروفورز، تنها یک سطح از الکترودها ولی در میدان متناوب هر دو الکترود پوشش داده می‌شوند و مساحت پوشش‌دهی نسبت به لایه‌نشانی در میدان مستقیم افزایش می‌یابد. به همین دلیل در سال‌های اخیر توجه زیادی به استفاده از میدان الکتریکی متناوب در لایه‌نشانی ذرات شده است. این روش مزایای بسیاری همچون صرفه‌جویی در زمان، هزینه، افزایش سرعت و کاهش تخریب ناشی از الکترولیز حلal دارد [۱۰۶].

در ادامه لایه‌نشانی در فرکانس‌های $0/1$ ، 1 ، 100 ، 1000 و 10000Hz در شرایط ولتاژ و زمان بهینه انجام شد.

درشت میکرومتری حکایت دارد که بر سطح الکترود قرار گرفته اند.



شکل ۳. لایه نشانی ذرات اکسید قلع در فرکانس 10kHz و نمودار فاکتور کلاسیوس- ماسوتی برای ذرات اکسید قلع دارای دو اندازه متفاوت.

برای بیان یکی از دلایل این رفتار ذرات، به نمودار توزیع اندازه ذرات در شکل (۵) توجه شد. با استفاده از کوچکترین و بزرگترین اندازه برای ذرات، که در نمودار توزیع وجود دارد سعی شد نمودار کلاسیوس- ماسوتی رسم شود. این نمودار توسط مدل پوسته که اولین بار گرین برای ذرات بیولوژی استفاده کرده بود، به دست آمد. با این تفاوت که مدل پوسته را برای ذرات دیالکتریک سرامیکی کروی شکل فرض نمودیم به صورتی که هسته ذره سرامیکی و پوسته آن، لایه مضاعف الکتریکی (EDL) باشد.

برای ترسیم فاکتور کلاسیوس- ماسوتی بر حسب فرکانس می‌توان با فرض کروی بودن ذرات اکسیدقلع ابعاد و پارامترهای مشخصی برای ذره، لایه مضاعف الکتریکی و محیط در جدول (۱) متصور شد. داده‌های جدول از مراجع و هندبوک‌ها و همچنین اندازه‌گیری تجربی به دست آمده است. مدل پوسته و نسبت موجود بین پارامترها برای ذره سرامیکی اکسیدقلع در شکل (۴) به صورت فرضی ترسیم شده است.

نیروهای دیالکتروفورزی تنها داخل شیار الکترودها توسط ذرات نانو پوشش داده می‌شوند.

با توجه به شکل (۲) در فرکانس 1kHz نشست بسیار ناچیزی مشاهده می‌شود. در این فرکانس نانوذرات در سطح الکترودها و درون گپ هیچ‌گونه نشستی نداشته‌اند. تاثیر جریان الکترواسمز در شسته شدن پودر از میان گپ‌ها نشستی را در بی نداشته زیرا نیروی الکترواسمز در این فرکانس بیشترین مقدار است [۲]. نیروهای کولمبی در این فرکانس به علت بالا بودن فرکانس و به عبارتی کم بودن زمان پیمایش ذرات در سطح الکترودها، قدرت لایه نشانی ذرات بر سطح الکترود را ندارند. بنابراین، در هر نیم‌سیکل ذرات مسیر بسیار ناچیزی از سطح را می‌پیمایند که عملاً فاصله‌ای از لبه الکترود ندارد به همین علت در این فرکانس لایه نشانی بر سطح الکترودها نیز مشاهده نمی‌شود. همچنین باید اشاره شود که بیشترین سرعت حرکت جریان سیال در لبه الکترودهاست و با فاصله گرفتن از لبه‌ها و حرکت به سمت سطوح، سرعت جریان سیال کاهش می‌یابد [۲].

در فرکانس‌های بالای 1kHz تاثیر نیروی دیالکتروفورز بر ذرات افزایش یافته و در سرنوشت ذرات تاثیر می‌گذارد. تکرار لایه نشانی در فرکانس 10kHz در شکل (۳) گویای این مطلب می‌باشد. به دنبال کاهش نسیبی نیروی الکترواسمز در فرکانس‌های بالاتر از 1kHz و افزایش نیروی دیالکتروفورز سرنوشت ذره تغییر می‌نماید. براساس شکل (۳) تاثیر این نیرو بر ممانهای دوقطبی ایجاد شده در میدان الکتریکی غیریکنواخت باعث حرکت ذرات از نقاط با دانسیته میدان کم به سمت لبه الکترودها که دارای بیشترین دانسیته میدان الکتریکی است، شده و منجر به پرشدن گپ می‌گردد.

برای ذرات اکسیدقلع نیروی دیالکتروفورز در این فرکانس مثبت است زیرا از دیدگاه تجربی طبق تصویر گرفته شده در شکل (۳) از پودر لایه نشانی شده در فرکانس 10kHz واضح می‌باشد که ذرات اکسیدقلع درون لبه و گپ الکترودها نشست یافته‌اند و از آنجایی که لبه قویترین نقطه میدان در جذب ذرات است بنابراین به ویژگی مثبت بودن دیالکتروفورز پی برده خواهد شد.

از سویی دیگر، مشاهده دقیق‌تر لایه نشانی ذرات اکسیدقلع در فرکانس 10kHz در شکل (۳)، از وجود ذرات

کلاسیوس- ماسوتی یکی از پارامترهای موثر در مباحث الکتروکیتیکی است که طبق رابطه زیر با نیروی دیالکتروفورز مناسب است [۲].

$$F_{DEP} = 2\pi\epsilon_0 a^3 Re[k(\omega)] \nabla E^2 \quad (1)$$

که در آن ϵ_0 ثابت دیالکتریک خلاء، a شعاع ذرات، ∇E گرادیان میدان الکتریکی و $Re[k(\omega)]$ قسمت حقیقی فاکتور کلاسیوس- ماسوتی است. فاکتور کلاسیوس- ماسوتی به عوامل مختلفی وابسته می‌باشد که یکی از مهمترین آنها، اندازه ذرات است که بر آن تاثیرگذار بوده و در نتیجه سبب تغییر نیروی دیالکتروفورز می‌گردد. این فاکتور به صورت رابطه زیر ارایه شده است [۲]:

$$k(\omega) = \left(\frac{\epsilon_p^* - \epsilon_m^*}{\epsilon_p^* + 2\epsilon_m^*} \right) \quad (2)$$

که در این رابطه ϵ_m^* و ϵ_p^* به ترتیب ثابت دیالکتریک مختلط ذره و محیط هستند که از رابطه زیر به دست می‌آیند: [۲]

$$\epsilon^* = \epsilon - i \left(\frac{\sigma}{\omega} \right) \quad (3)$$

۵ هدایت پذیری محیط یا ذره و ۶ نیز فرکانس زاویه‌ای است.

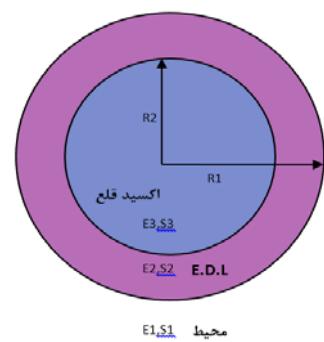
برای ترسیم فاکتور کلاسیوس- ماسوتی بر حسب فرکانس می‌توان از مدل پوسته که اولین بار گرین برای ذرات بیولوژی دارای چند لایه پیشنهاد کرد، استفاده نمود. در این مدل با فرض ذره کروی دارای تک لایه بر سطح، مقدار موثر پلاریزاسیون و ممان دوقطبی به صورت زیر تعریف شده است:

$$\tilde{\alpha} = 3\epsilon_1 \tilde{f}_{CM,23} = 3\epsilon_m \left(\frac{\tilde{\epsilon}_{23} - \tilde{\epsilon}_1}{\tilde{\epsilon}_{23} - 2\tilde{\epsilon}_1} \right) \quad (4)$$

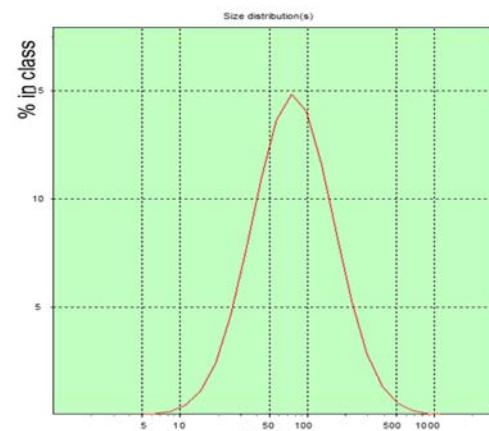
$$P = 4\pi\epsilon_1 \tilde{f}_{CM,23} a_1^3 E \quad (5)$$

۷ که در آن ثابت دیالکتریک مختلط

به صورت زیر تعریف شده است:



شکل ۴. مدل ذره سرامیکی و نسبت موجود بین پارامترها.



شکل ۵. آنالیز اندازه دانه از پودرناژذرات اکسیدقلع.

جدول ۱. داده‌های ترسیم نمودار فاکتور کلاسیوس- ماسوتی برای ذرات اکسیدقلع با تغییر هدایت الکتریکی EDL.

ضخامت ذره [nm] درشت	ضخامت ذره [nm] ریز	ثابت دیالکتریک	هدایت الکتریکی [S/m]	منطقه
---	---	۲ ۱	0.2×10^{-2} 0.2×10^{-3}	محیط
۰.۱	۰.۵	۲ ۱	5×10^{-2} 5×10^{-3}	EDL
۵۰۰	۱۰	۱ ۴	0.2×10^{-8} 0.2×10^{-7}	ذره

سپس از طریق نرم‌افزار متلب، معادلات این مدل نوشته و نمودار ترسیم شد.

*طبق مطالعات انجام گرفته توسط میکایل [۱]، برای محاسبه مقدار هدایت الکتریکی کلی ذره از رابطه $\sigma_p = \sigma_{pbulk} + \frac{2K_s}{r}$ استفاده شده است. قسمت دوم این عبارت مربوط به هدایت الکتریکی ناشی از تجمع بار الکتریکی بر سطح ذره و ناحیه EDL است که مربوط به شعاع ذره دانسته است. K_s هدایت الکتریکی در سطح است که در محیط های آبی مقدار 1ns برآورد شده است. بنابراین می‌توان این عبارت را برای تخمین هدایت الکتریکی EDL ذرات اکسیدقلع در این پژوهش استفاده کرد. در نتیجه با توجه به مقدار هدایت سطحی 1ns و شعاع 40nm ذرات اکسیدقلع مقدار هدایت الکتریکی EDL برای ذرات 0.05s/m به دست آمد.

۴- نتیجه‌گیری

وجود ذرات درشت بر سطح الکترود در لایه نشانی ذرات اکسیدقلع در فرکانس 10 kHz به علت وجود اندازه ذرات متفاوت در سوسپانسیون لایه‌نشانی است. مقادیر فاکتور کلاسیوس ماسوتی برای ذرات ریز نشان دهنده نوع مثبت دی‌الکتروفورز و در نتیجه نشست بر لبه الکترود با تمرکز میدان الکتریکی بالا می‌باشد. محاسبه مقادیر فاکتور کلاسیوس ماسوتی برای ذرات درشت نیز حاکی از نوع منفی نیروی دی‌الکتروفورز و در نتیجه فاصله گرفتن ذرات از لبه به سمت سطح الکترود است.

مراجع

1. M. Amman, electrophoretic deposition under modulated electric fields: a review, *RSC Advances*, 2, 7633–7646, 2012.
2. H. Morgan, N. G. Green, AC Electrokinetics: Colloids and nanoparticles, *Research Studies Press*, England, 2002.
3. L. Besra, M. Liu, A review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD), *Progress in Materials Science* 52, 1-61, 2007.
4. R. Riahifar, E. Marzbanrad, B. Raissi, C. Zamani, M. Kazemzad, A. Aghaee, Sorting ZnO particles of different shapes with low frequency AC electric fields, *Materials Letters*, 65, 4, 632–635, 2011.
5. R. Riahifar, B. Raissi, E. Marzbanrad, C. Zamani, Effect of parameters on deposition pattern of ceramic nanoparticles in non-uniform AC electric field, *J Mater Sci: Mater Electron*, 22, 40–46, 2011.
6. T. Yoshioka, A. Chavez-Valdez, J.A. Roether, D.W. Schubert, A.R. Boccaccini, AC electrophoretic of organic-inorganic composite coatings, *Journal of Colloid and Interface Science*, 392, 1, 167-171, 2013.
7. W. Ahmed, E. StefanKooij, A. Van Silfhout, B. Poelsema, Quantitative analysis of gold nanorod alignment after electric field-assisted deposition, *nano letters*, 9, 11, 3786-3794, 2009.
8. ریاحی فر، ر. مدلسازی حرکت نانوذرات سرامیکی در الکتروولت توسعه میدان الکتریکی متناوب، تر. دکترا، پژوهشگاه مواد و انرژی، ۱۳۸۹.
9. قشقابی، س. تاثیر نانواختار و روش لایه نشانی ZnO بر رفتار سنگینی آن، ترکارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی، ۱۳۹۰.
10. Riahifar, R., Marzbanrad, E., B. RaissiDehkordi, C. Zamani, Role of substrate potential on filling the gap between two planar parallel electrodes in electrophoretic deposition, *Materials Letters* 64, 559–561, 2010.
11. J. Kadaksham, P. Singh, N. Aubry, Manipulation of particles using dielectrophoresis, *Mechanics Research Communications* 33, 108-122, 2006.
12. C. Wei, T. Wei, CH. Liang, FC. Tai, The separation of different conducting multi-walled carbon nanotubes by AC dielectrophoresis, *Diamond Relat Mater*, 18:332–6, 2009.

$$\frac{\tilde{\varepsilon}_{23}}{\tilde{\varepsilon}_2} = \frac{\left[\gamma_{12}^3 + 2 \left(\frac{\tilde{\varepsilon}_3 - \tilde{\varepsilon}_2}{\tilde{\varepsilon}_3 + 2\tilde{\varepsilon}_2} \right) \right]}{\left[\gamma_{12}^3 - \left(\frac{\tilde{\varepsilon}_3 - \tilde{\varepsilon}_2}{\tilde{\varepsilon}_3 + 2\tilde{\varepsilon}_2} \right) \right]} \quad \text{معادله (۶)}$$

که در آن $a_1/a_2 = \gamma_{12}$ است به صورتی که a_1 شعاع ذره و لایه مضاعف الکتریکی و a_2 شعاع ذره است [۲]. در این مدل ذره سرامیکی کروی و لایه مضاعف الکتریکی حول آن، تک‌لایه برای مدل پوسته گرین تصور شد. با استفاده از داده‌های موجود فاکتور کلاسیوس - ماسوتی برای دو اندازه ذره متفاوت ترسیم شد که در شکل (۳) مشاهده می‌شود. مقدار فاکتور کلاسیوس - ماسوتی با توجه به نمودار، تحت تاثیر اندازه ذره بوده و با افزایش قطر ذره مقدار آن کاهش یافته و در نتیجه مقدار و نوع نیروی دی‌الکتروفورز تغییر کرده است. مطابق شکل (۴) توزیع اندازه ذرات بین 10 nm و $0.5\text{ }\mu\text{m}$ به دست آمد و برای این دو مقدار فاکتور کلاسیوس - ماسوتی ترسیم شد. بر این اساس در شکل (۳)، مقدار فاکتور کلاسیوس - ماسوتی برای ذره با قطر 10 nm مثبت ولی برای ذره با قطر $0.5\text{ }\mu\text{m}$ عددی منفی به دست آمد در حالی که برای بقیه اندازه ذرات مقدار فاکتور کلاسیوس - ماسوتی مابین مقدار منفی و مثبت تغییر می‌کند در نتیجه نیروی مثبت دی‌الکتروفورز سبب تجمع ذرات در لبه الکترودها و نشست بر لبه و گپ شده اما نیروی منفی دی‌الکتروفورز بر ذرات درشت وارد شده است و آنها را از لبه الکترود دور کرده و به سمت نقاط غیرتمترکز میدان حرکت می‌دهد. بنابراین، می‌توان احتمال داد یکی از دلایل وجود ذرات درشت بر سطح الکترودها نیروی منفی دی‌الکتروفورز بوده که سبب دور نمودن ذرات از لبه الکترود شده است. این رفتار ذرات و تاثیر اندازه آنها در نوع نیروی دی‌الکتروفورز موضوع مهمی است که بسیاری از محققین از آن برای جداسازی ذرات درشت از ریز استفاده کرده و نتایج مهمی به دست آورده‌اند. بر این اساس، یکی از نتایج مهمی که در این بخش می‌توان ارائه نمود استفاده از میدان‌های الکتریکی متناوب برای جداسازی ذرات با توزیع اندازه دانست که به عنوان پتانسیلی برای موضوعات تحقیق برای دیگر محققین پیشنهاد می‌شود [۱۲, ۱۱].